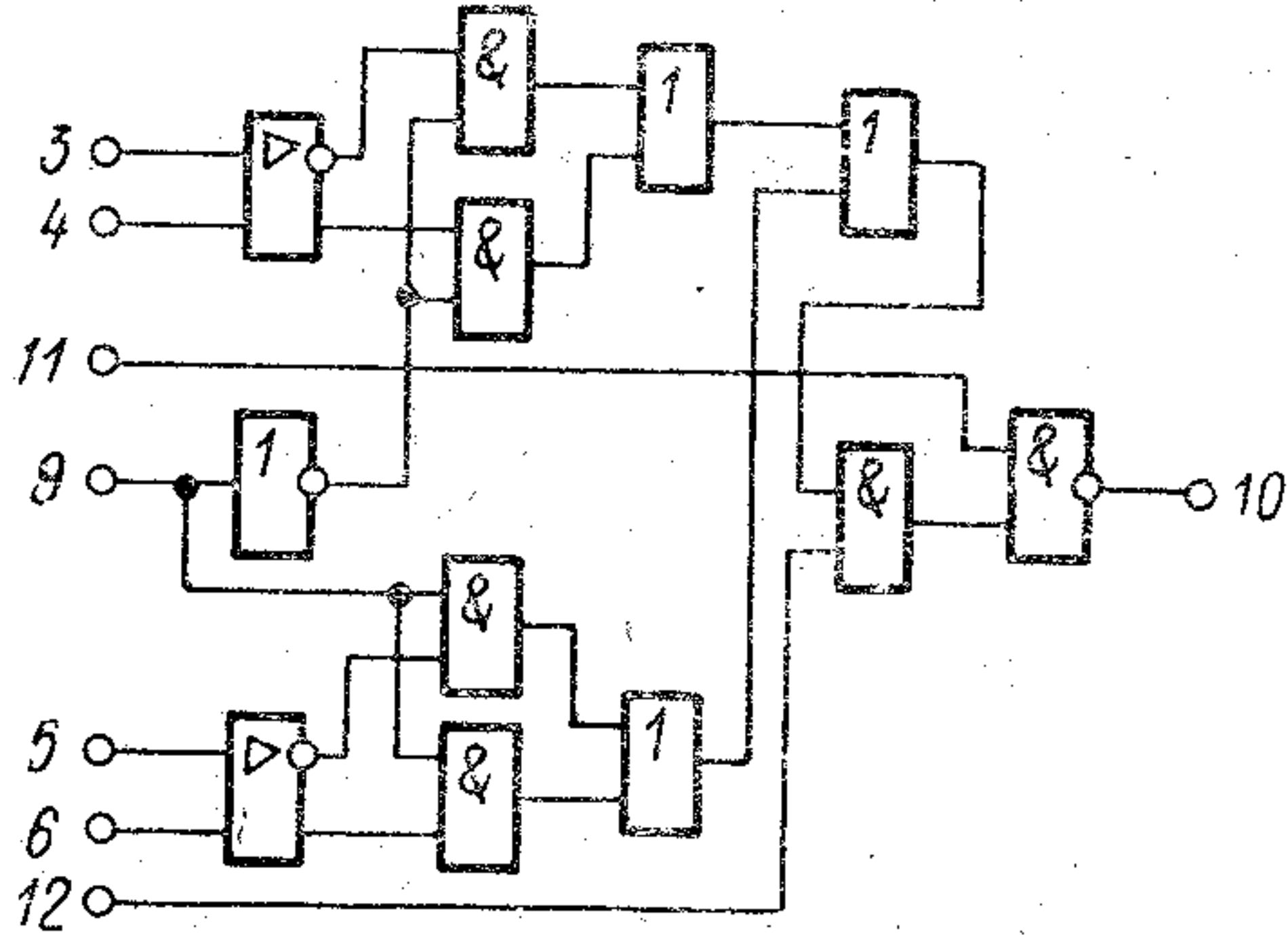


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА



- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 — напряжение порога $U_{пор}$  | 8 — общий                        |
| 2 — напряжение смещения $U_{см}$ | 9 — вход управления каналами $W$ |
| 3 — вход $X1$                    | 10 — выход $Y$                   |
| 4 — вход $X2$                    | 11 — строб-вход $S1$             |
| 5 — вход $X3$                    | 12 — строб-вход $S2$             |
| 6 — вход $X4$                    | 13 — свободный                   |
| 7 — минус 5 В                    | 14 — +5 В                        |

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре  $25 \pm 5^\circ\text{C}$ )

Напряжение питания, В . . . . .	$\pm 5 \pm 10\%$
Ток потребления при низком уровне выходного напряжения, мА:	
по выводу 7, не менее . . . . .	минус 26
»  »  14, не более . . . . .	36
Входной ток, мА:	
низкого уровня, не менее	
по выводам 9, 12 . . . . .	минус 1,0
»  выводу 11 . . . . .	минус 1,6
высокого уровня, не более	
по выводам 9, 12 . . . . .	0,025
»  выводу 11 . . . . .	0,04
Выходное напряжение, В:	
низкого уровня, не более . . . . .	0,4
высокого уровня, не менее . . . . .	2,4
Время задержки распространения при включении, нс, не более . . . . .	50

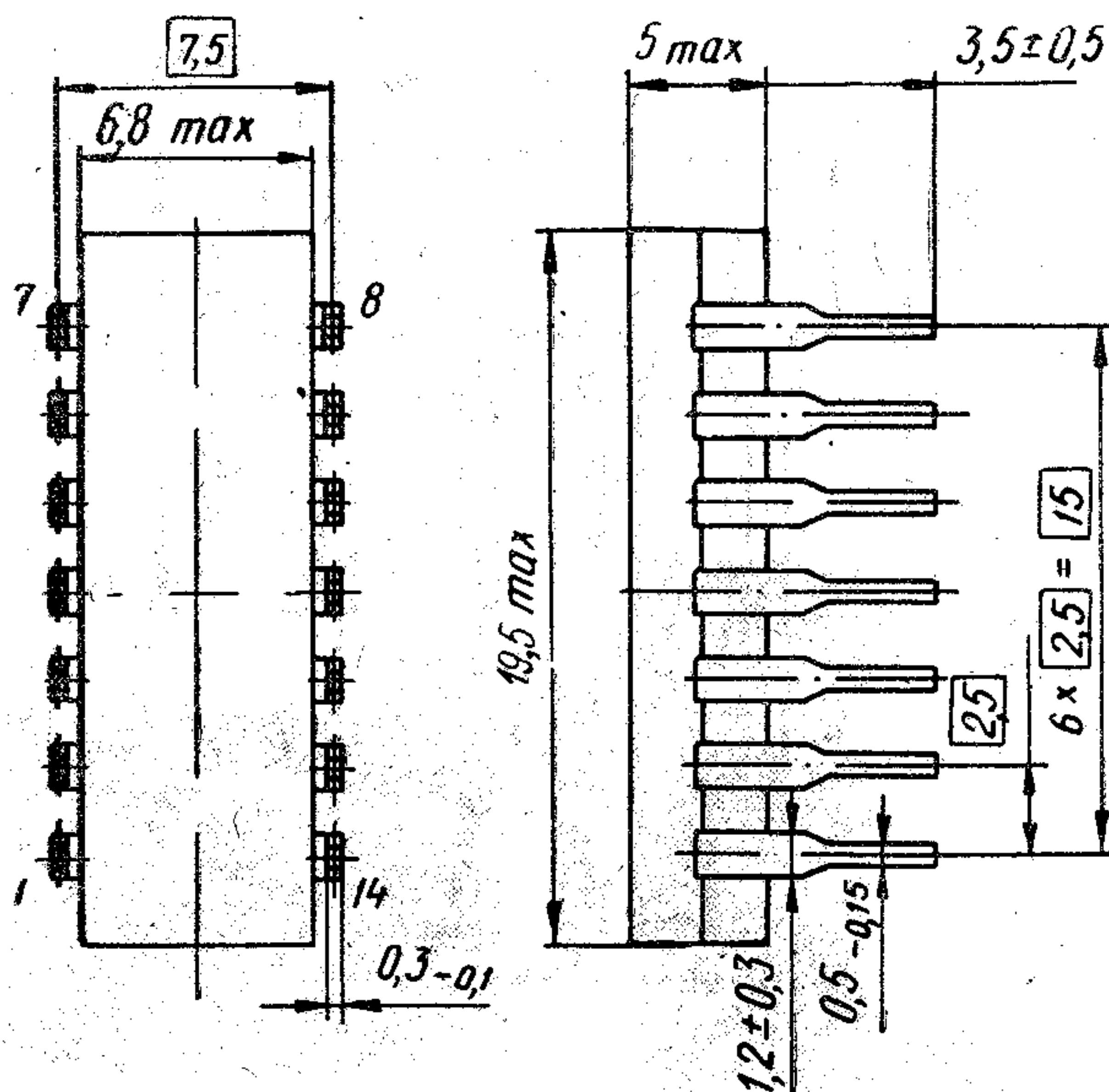
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ  
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальное напряжение питания (кратковременно в течение 5 мс), В:	
по выводу 7 . . . . .	7
» » 14 . . . . .	минус 7
Максимальное напряжение на выходе закрытой схемы (кратковременно в течение 5 мс), В . . . . .	
	7
Напряжение между выводами 3 и 4 или 5 и 6 (кратковременно в течение 5 мс), В:	
максимальное . . . . .	2
минимальное . . . . .	минус 2
Максимальное напряжение питания порога (кратковременно в течение 5 мс), В . . . . .	
	минус 7,5
Напряжение питания смещения (кратковременно в течение 5 мс), В . . . . .	
	от минус 2 до +2
Напряжение на выводах 3—6, В:	
максимальное . . . . .	4,5
минимальное . . . . .	минус 4,5
Напряжение на строб-входах, В . . . . .	
	от 0 до 5,5

# МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 170

## Общие данные

### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ МИКРОСХЕМ (КОРПУС 201.14-2)



Масса не более 1 г

Нумерация выводов микросхем показана условно.

### ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц . . . . .	от 1 до 5000
амплитуда ускорения, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g) . . . . .	400 (40)

Механический удар:

одиночного действия

пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g) . . . . .	10 000 (1000)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 0,1 до 2,0

многократного действия

пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g) . . . . .	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 1 до 5

Линейное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g) . . . . .	5000 (500)
--	------------

# МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 170

## Общие данные

Акустический шум:	
диапазон частот, Гц . . . . .	50—10 000
уровень звукового давления, дБ . . . . .	160
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.):	
для микросхемы 170АП2 . . . . .	$1,3 \cdot 10^{-4}$ ( $10^{-6}$ )
» остальных микросхем . . . . .	665 (5)
Атмосферное повышенное давление, атм . . . . .	3
Повышенная температура среды, °С . . . . .	70
Пониженная температура среды, °С . . . . .	минус 10
Изменения температуры окружающей среды, °С . . . . .	от минус 10 до +70
Повышенная относительная влажность при температуре 35°С, % . . . . .	98
Иней, роса.	
Соляной туман.	
Среда, зараженная плесневыми грибами.	

## НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка $\ominus$ , ч . . . . .	50 000
Срок сохраняемости $\ominus$ , лет . . . . .	25

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 073.041—82 и требованиями, изложенными ниже.

Запрещается подведение каких-либо электрических сигналов (в том числе шин «питание» и «земля») к выводам микросхем, используемым согласно схеме.

При ремонте аппаратуры и при контроле параметров микросхем в контактирующих устройствах замену микросхем необходимо производить только при отключенных источниках питания.

При работе с микросхемами должны быть приняты меры по защите от воздействия электростатического заряда.

Предельное значение электростатического потенциала 500 В.

$\ominus$  В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.